

Toshiba Memory Europe представила новое поколение Serial Interface NAND

Микросхемы NAND второго поколения поддерживают высокую скорость передачи данных и повышают производительность и ёмкость конечных устройств.

Дюссельдорф, Германия, 26 сентября 2019 года — Toshiba Memory Europe сегодня представила второе поколение флэш-памяти NAND для встраиваемых решений, которое отличается повышенной ёмкостью и производительностью^[1]. Благодаря высокой скорости передачи данных новые продукты Serial Interface NAND совместимы с популярным интерфейсом SPI и подходят для применения в широком спектре потребительских, промышленных и коммуникационных решений. Отгрузка тестовых образцов микросхем начинается сегодня, а массовое производство запланировано на октябрь этого года.

По мере того, как уменьшаются габариты устройств интернета вещей и сферы коммуникаций, растёт спрос на флэш-память в миниатюрных корпусах с малым количеством контактов, которая может обеспечить высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря совместимости с широко распространённым интерфейсом SPI, продукты линейки Serial Interface NAND могут использоваться в качестве флэш-памяти SLC NAND с малым количеством контактов и отличаются высокой ёмкостью и компактными размерами.

Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, новые продукты Serial Interface NAND второго поколения отличаются увеличенной (по сравнению с первым поколением) производительностью^[1], включая поддержку рабочей частоты 133 МГц и режима program x4. Помимо этого, чтобы удовлетворить спрос на большие объёмы памяти, в новую линейку

входит решение ёмкостью 8 Гбит^[2] (1 ГБ^[2]). Все микросхемы выпускаются в 8-контактных корпусах типоразмера WSON^[3] габаритами 6 x 8 мм.

Основные особенности

- **Ёмкость 1 – 8 Гбит**
- **Размеры страницы памяти 2 Кбит (1/2 Гбит) и 4 Кбит (4/8 Gb)** для более эффективного чтения/записи данных ОС
- **Режимы x4 Program и Read** для повышения скорости доступа и производительности при программировании
- **Поддержка ECC и защиты данных** выявляет инвертирование разрядов и обеспечивает защиту выделенных блоков
- **Функция Parameter Page** для получения подробных данных об устройстве

«Сложность встраиваемых устройств и требования к их габаритам постоянно растут, поэтому разработчикам требуются гибкость и производительность, которые может обеспечить новая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лидера в сфере 3D-флэш-памяти, они выбирают инновационные технологии, компактные размеры и надёжность, от которых в итоге выигрывают и конечные потребители».

Отгрузка тестовых экземпляров микросхем начинается уже сегодня, а массовые поставки продукта запланированы на октябрь 2019 года.

Примечания:

[1] По сравнению с продуктами Serial Interface NAND производства Toshiba Memory первого поколения. Данные исследования Toshiba Memory.

[2] Ёмкость продукта определяется на основе ёмкости установленных в нём микросхем памяти, а не доступного конечным пользователям объёма памяти для хранения данных. Доступная пользователю реальная ёмкость будет ниже указанной из-за наличия областей служебных данных, форматирования, поврежденных блоков и прочих ограничивающих факторов, также на ёмкость влияют хост-устройство и сценарии его применения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками конкретного продукта.

[3] Корпус WSON (Very-Very thin Small Outline No Lead Package)

Все названия компаний, продуктов и услуг могут являться товарными знаками соответствующих компаний-владельцев.

К каждому упоминанию продуктов Toshiba Memory: Плотность записи конкретного продукта определяется на основе плотности установленных в нём микросхем, а не доступного конечным пользователям объема памяти для хранения данных. Доступная пользователю реальная ёмкость будет ниже указанной из-за наличия областей служебных данных, форматирования, поврежденных блоков и прочих ограничивающих факторов, также на ёмкость влияют хост-устройство и сценарии его применения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками конкретного продукта. 1 Гбит = 2^{30} бит = 1 073 741 824 бит. 1 ГБ = 2^{30} байт = 1 073 741 824 байт. 1 Кбайт = 2^{10} байт = 1024 байта.

###

О компании Toshiba Memory Europe

Компания Toshiba Memory Europe GmbH – европейское подразделение корпорации Toshiba Memory Corporation. Компания предлагает широкий спектр высокоэффективной продукции на основе флеш-памяти, включая SD-карты, USB-накопители и компоненты со встроенной памятью, а также твердотельные накопители (SSD). Офисы компании расположены в Германии, Франции, Испании, Швеции и Великобритании. Президент компании — Масару Такеучи (Masaru Takeuchi).

Дополнительные сведения о полном ассортименте накопителей и SSD компании см. на сайте business.toshiba-memory.com

Контакты по вопросам публикации:

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0)211 368 77-0 Fax: +49 (0) 211 368 774 00

E-mail: support@toshiba-memory.com

Контакты по редакционным вопросам:

Sandrine Aubert, Toshiba Memory Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 579

E-mail: SAubert@toshiba-tme.eu

Публикация:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com